ДИНАМИКА РЕШЕТКИ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ

УДК 548.0 : 537.226

ВНУТРЕННЕЕ ТРЕНИЕ В СОПОЛИМЕРЕ ВИНИЛИДЕНФТОРИДА С ТРИФТОРЭТИЛЕНОМ ПРИ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ

© 2019 г. К. А. Верховская^{1,*}, Л. Н. Коротков², О. А. Караева³

¹ Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН, Москва, Россия ² Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия

> ³ ЗАО "Русавиаинтер", Воронеж, Россия * E-mail: vkira123@gmail.com Поступила в редакцию 27.12.2018 г. После доработки 27.12.2018 г. Принята к публикации 23.01.2019 г.

В интервале температур 290–420 К на частоте $f \approx 16$ Гц изучены температурные зависимости внутреннего трения Q^{-1} , полученные при различных скоростях нагрева образца сополимера ВДФ/ТрФЭ (75/25). Показано, что наблюдаемый в окрестностях сегнетоэлектрического фазового перехода ($T_c = 393$ К) максимум Q^{-1} связан с движением межфазных границ и может быть описан в рамках низкочастотного флуктуационного механизма внутреннего трения. Определен параметр размытия сегнетоэлектрического фазового перехода σ . Полученное значение σ существенно превышает величину, обусловленную возможной микронеоднородностью химического состава.

DOI: 10.1134/S0023476119040271

ВВЕДЕНИЕ

Сополимеры поливинилиденфторида-трифторэтилена (**ВДФ/ТрФЭ**) являются известными сегнетоэлектриками [1-4]. Наряду с кристаллической фракцией полимер содержит аморфную фазу, доля которой зависит от технологии приготовления материала. Сегнетоэлектрический фазовый переход первого рода реализуется в кристаллической фракции, которая по одним данным характеризуется орторомбической [3], а по другим – моноклинной [4] элементарной ячейкой.

Упругие и диэлектрические свойства сополимеров ВДФ/ТрФЭ, в частности механизмы упругих и диэлектрических потерь, связанные с релаксационными процессами, обусловленными замораживанием движения участков молекулярных цепей, достаточно хорошо изучены в широком диапазоне частот [2, 3]. В [5–7] обсуждается дисперсия диэлектрического отклика вблизи температуры сегнетоэлектрического фазового перехода (T_c) в ультратонких пленках ВДФ/ТрФЭ.

Наряду с этим вопросы, касающиеся диссипации упругой энергии в диапазоне низких и инфранизких частот в окрестностях T_c в полимерных сегнетоэлектриках, до сих пор не затрагивались. Можно ожидать, что значительный вклад в рассеяние упругой энергии (внутреннее трение — Q^{-1}) будет давать универсальный механизм [8, 9], называемый "низкочастотным флуктуационным механизмом внутреннего трения". Данный механизм учитывает кинетику превращения вещества из одной фазы в другую в области размытого фазового перехода первого рода [8, 9].

В неоднородном температурном поле в образце, нагреваемом или охлаждаемом в ходе эксперимента с некоторой скоростью $\dot{T} \approx dT/dt$, фазовый переход реализуется не одновременно во всем объеме вещества, а в отдельных микрообластях с объемом $V_0 \approx (10-100 \text{ нм})^3$. Учитывая зависимость времени активации каждого зародыша от измерительного упругого напряжения, можно получить выражение для высоты максимума внутреннего трения (Q_{max}^{-1}) в окрестностях T_c [8, 9]:

$$Q_{\rm max}^{-1} = EV_0 \chi_s^2 T' / (kT_c f \Delta T), \qquad (1)$$

где k — постоянная Больцмана, E — упругий модуль, f — измерительная частота, ΔT — полуширина максимума зависимости $Q^{-1}(T)$, χ_s — спонтанная деформация, V_0 — объем критического зародыша.

Целью данной работы являются выяснение реализации низкочастотного флуктуационного механизма внутреннего трения в окрестностях структурного фазового перехода в полимерных



Рис. 1. Температурные зависимости упругого модуля (1) и внутреннего трения (2) для сополимера ВД $\Phi/T\Phi\Im$ (75/25) на частоте около 16 Гц в режиме нагрева со скоростью 1 К/мин. На вставке — температурная зависимость внутреннего трения в кремневой подложке.

сегнетоэлектриках и оценка в рамках модели [8] размеров критического зародыша.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Для проведения эксперимента использовали маятник изгибных колебаний. Образец представлял собой кремниевую пластинку размером $8 \times 9 \times 0.2 \text{ мм}^3$. На ее поверхность наносили раствор сополимера ВДФ/ТрФЭ (75/25) в ацетоне. После испарения растворителя на поверхности пластины образовалась полимерная пленка толщиной $m \approx 20$ мкм. Для удаления остатков растворителя образец просушивали при температуре 90°C в течение 24 ч.

Таким образом, исследуемый образец представлял собой двухслойную структуру. Внутрен-

нее трение такой структуры Q_{tot}^{-1} при условии, что толщина полимерной пленки $m \ll l$, где l – общая толщина структуры полимер—подложка, может быть описано формулой [10]:

$$Q_{\text{tot}}^{-1} \approx 3m E_1 Q^{-1} / l E_0, \qquad (2)$$

где E_0 и E_1 – значения модуля Юнга подложки и пленки соответственно. Предполагается, что вклад

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 64 № 4 2019

подложки во внутреннее трение пренебрежимо мал. Тогда внутреннее трение материала пленки можно найти по формуле $Q^{-1} = Q_{tot}^{-1} l E_0 / 3m E_1$. При вычислениях Q^{-1} брали значения $E_0 = 18.9$ ГПа [11] и $E_1 \approx 4$ ГПа [3], полагая, что эти величины слабо зависят от температуры в условиях эксперимента.

Наряду с внутренним трением измеряли частоту колебаний маятника *f*, квадрат которой пропорционален упругому модулю образца *E*.

Для оценки вклада подложки в Q_{tot}^{-1} в интервале температур 300–473 К были проведены измерения внутреннего трения в подложке Q_s^{-1} (вставка к рис. 1). Полученная зависимость $Q_s^{-1}(T)$ является монотонной возрастающей функцией температуры, при этом величина Q_s^{-1} в исследуемом интервале 300–420 К лежит в пределах (20–25) × 10⁻⁴.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Температурные зависимости упругого модуля и внутреннего трения полимерного образца показаны на рис. 1. Можно заметить, что при $T \le 420$ К внутреннее трение в полимерной пленке существенно превышает Q_s^{-1} , что позволяет пренебречь вкладом подложки в диссипацию упругой энергии в системе подложка–полимерная пленка.

Зависимость $Q^{-1}(T)$ имеет сложный вид. Видно, что с повышением температуры в интервале 300—310 К происходит значительное уменьшение Q^{-1} , связанное с процессом размораживания сегментальной подвижности выше температуры стеклования $T_1 \approx 240$ К в микрообластях, обогащенных ВДФ [3].

Вблизи температуры $T_2 \approx 314$ К просматривается аномалия Q^{-1} , связанная с процессом размораживания молекулярной подвижности в областях, обогащенных ТрФЭ [3]. Максимум Q^{-1} вблизи $T_c \approx 394$ К обусловлен сегнетоэлектрическим фазовым переходом в кристаллической фракции образца. Пик внутреннего трения при $T_m \approx 414$ К, согласно T—x-фазовой диаграмме системы [3, 4], соответствует температуре плавления материала.

Модуль *E* в интервале температур, доступных в эксперименте, монотонно понижается. При этом характерный минимум, обусловленный смягчением решетки вблизи T_c , отчетливо проявляющийся в случае сополимера ВДФ/ТрФЭ (60/40) [12], в условиях проводимого эксперимента не выявлен. По-видимому, это связано с близостью температуры плавления исследуемого материала



Рис. 2. Температурные зависимости Q^{-1} для сополимера ВДФ/ТФЭ (75/25) вблизи T_c , полученные в ходе нагрева со скоростью 1 (1), 3 (2), 6 (3) и 9 (4) К/мин (а); аналогичные зависимости после вычитания фоновой составляющей внутреннего трения (6).

 $(T_m \approx 414 \text{ K})$, вблизи которой регистрируется сильное уменьшение модуля упругости.

Рассмотрим упругие потери в окрестностях Т. Низкочастотный флуктуационный механизм внутреннего трения предсказывает рост пика Q^{-1} с повышением скорости прохождения области фазового перехода в соответствии с формулой (1). Действительно, анализ результатов измерений Q^{-1} , выполненных при различных скоростях нагрева, обнаружил увеличение максимума внутреннего трения Q_{max}^{-1} с увеличением темпа нагрева образца (рис. 2а). Вместе с тем можно заметить, что с повышением возрастает и фоновая составляющая упругих потерь, обусловленная действием других механизмов. Поэтому для выделения вклада низкочастотного флуктуационного механизма O^{-1} из экспериментальных данных была вычтена фоновая составляющая. Полученные кривые $O^{-1}(T)$ представлены на рис. 2б.

Нетрудно убедиться, что Q_{max}^{-1} пропорционально скорости нагрева образца (рис. 3).

Воспользуемся экспериментальными результатами и уравнением (1) для оценки объема критического зародыша: $V_0 = Q_{\text{max}}^{-1} kT_c f \Delta T / (E_1 \chi_s^2 dT/dt) \approx \approx 4 \times 10^{-17} \text{ см}^3$. При вычислениях принимали во внимание, что полуширина пика внутреннего трения $\Delta T \approx 7 \text{ K}, E_1 \approx 4 \Gamma \Pi a$ [3]; $\chi_s \approx 6 \times 10^{-3}$ [1].

Сравним полученное значение V_0 с объемом критического зародыша для других сегнетоэлектрических материалов. Так, $V_0 \approx 10^{-19}$ см³ [9] и $V_0 \approx 10^{-18}$ см³ [13] в случае дигидрофосфата калия и титаната бария соответственно. Видно, что среди перечисленных сегнетоэлектриков объем крити-

ческого зародыша имеет наибольшее значение в полимерном материале. Вероятно, это связано с тем, что в отличие от обычных сегнетоэлектриков структурный фазовый переход в ВДФ/ТрФЭ сопровождается не только изменением параметра кристаллической решетки, но и заметным изменением конформационного состояния молекулярных цепей [4].

Полученные экспериментальные результаты позволяют оценить степень размытия сегнетоэлектрического фазового перехода (σ) в исследуемом материале. Поскольку максимум зависимости $Q^{-1}(T)$ в окрестностях T_c обусловлен движе-



Рис. 3. Зависимость величины максимума внутреннего трения от скорости нагрева образца.

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 64 № 4 2019

нием межфазных границ, то, очевидно, величина σ может быть приблизительно определена по полуширине максимума $Q^{-1}(T)$. В случае ВДФ/ТрФЭ (75/25) имеем $\sigma \approx \Delta T \approx 7$ К.

В рамках модели Смоленского–Исупова [14] размытый фазовый переход, реализующийся в твердом растворе, рассматривается как совокупность локальных фазовых переходов с локальными температурами Кюри (θ). Разброс θ объясняется микрофлуктуациями состава твердого раствора. В модели [14] параметр σ имеет смысл среднеквадратичного отклонения локальных температур Кюри в отдельных микрообластях с размерами порядка критического зародыша относительно некоторой средней температуры.

Модель дает следующее выражение для σ [14]:

$$\sigma = [\gamma^2 x (1 - x)/n]^{1/2}.$$
 (3)

Здесь параметр $\gamma = dT_c/dx$ определяет скорость изменения температуры Кюри при изменении мольной концентрации компонентов *x*, *n* – число частиц в микрообласти, имеющей размер критического зародыша.

Воспользовавшись полученной выше оценкой критического зародыша $V_0 \approx 4 \times 10^{-17} \text{ см}^3$, найдем $n = V_0/V_c \approx 1.82 \times 10^4$, где $V_c \approx 2.2 \times 10^{-21} \text{ см}^3$ [3]. Согласно *T*-*x*-фазовой диаграмме системы ВДФ/ТрФЭ [3, 4] $\gamma \approx 350$ К/моль. Тогда для состава с x = 0.25 находим $\sigma \approx 0.4$ К.

Таким образом, в сополимерах винилиденфторида и трифторэтилена флуктуации состава дают незначительный вклад в σ . Можно предположить, что размытие сегнетоэлектрического фазового перехода преимущественно обусловлено его спецификой, связанной с изменением конформационного состояния молекулярных цепей в ходе структурного перехода [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ экспериментальных результатов показал, что наблюдаемый в окрестностях T_c максимум внутреннего трения связан с движением межфазных границ и может быть описан в рамках низкочастотного флуктуационного механизма внутреннего трения [8, 9]. Сделанные на основе модели [8, 9] оценки объема критического зародыша дали величину порядка 10^{-17} см³, что несколько больше, чем в случае канонических сегнетоэлектриков, например BaTiO₃ и KH₂PO₄.

Определена величина параметра размытия сегнетоэлектрического фазового перехода. Полученное значение $\sigma \approx 7$ К существенно превышает величину, определенную в рамках модели Смоленского–Исупова [14]. Следовательно, наблюдаемое в эксперименте размытие фазового перехода не может быть объяснено микронеоднородностью химического состава.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Forukawa T. // Phase Transitions. 1989. V. 18. P. 143.
- Koizumi N., Hagino J., Murata Y. // Ferroelectrics. 1981. V. 32. P. 141.
- 3. *Лущейкин Г.А.* Полимерные пьезоэлектрики. М.: Химия, 1990. 176 с.
- 4. Кочервинский В.В. // Успехи химии. 1999. Т. 68. № 10. С. 904.
- 5. Лотонов А.М., Иевлев А.С., Гаврилова Н.Д. и др. // ФТТ. 2006. Т. 48. Вып. 6. С. 1101.
- 6. Верховская К.А., Плаксеев А.А., Ломотов А.М. и др. // ФТТ. 2009. Т. 51. Вып. 7. С. 1297.
- 7. Солнышкин А.В., Wegener М., Kunstler W., Gerhard-Multhaupt R. // ФТТ. 2008. Т. 50. Вып. 7. С. 542.
- Postnikov V.S., Gridnev S.A., Darinskii B.M., Sharshakov I.M. // Il Nuovo Cimento B. 1976. V. 33. № 1. P. 324.
- 9. Gridnev S.A., Darinskii B.M., Postnikov V.S. // Ferroelectrics. 1976. V. 14. P. 583.
- Даринский Б.М., Ильин А.С., Митрохин В.И., Ярославцев Н.П. // Твердотельная электроника и микроэлектроника. Воронеж: ВГТУ, 2005. С. 212.
- Барановский П.И., Клочков В.П., Потыкевич И.В. Полупроводниковая электроника. Справочник. Киев: Наукова думка, 1975. 704 с.
- 12. Korotkova T., Karaeva O., Naberezhnov A. et al. // Solid State Commun. 2012. V. 152. № 10. P. 846.
- Гриднев С.А., Даринский Б.М., Постников В.С. // Механизмы релаксационных явлений в твердых телах. Каунас: Каунасский политех. ин-т, 1974. С. 244.
- Смоленский Г.А., Боков В.А., Исупов В.А и др. Физика сегнетоэлектрических явлений / Под ред. Смоленского Г.А. Л.: Наука, 1985. 396 с.